

**ARRANGEMENT FOR TESTING SEMICONDUCTOR WAFERS OR THE LIKE**

**Patent number:** DE4109908  
**Publication date:** 1992-10-01  
**Inventor:** REITINGER ERICH (DE)  
**Applicant:** REITINGER ERICH (DE)  
**Classification:**  
- **international:** G01R31/28; G01R31/28; (IPC1-7): G01M19/00;  
G01R31/26; G01R31/28  
- **european:** G01R31/28E11  
**Application number:** DE19914109908 19910326  
**Priority number(s):** DE19914109908 19910326

**Also published as:**

-  EP0505981 (A2)
-  US5220277 (A1)
-  JP6104321 (A)
-  EP0505981 (A3)
-  EP0505981 (B1)

[Report a data error here](#)

Abstract not available for DE4109908

Abstract of corresponding document: **US5220277**

An apparatus for testing semiconductor wafers and the like includes a prober table for receiving the semiconductor wafers to be tested and a holder receiver for receiving holders for probes or test needles. The prober table is arranged within a container having an open upper portion that has a plate having an opening through which pass the probes or test needles into the container. Discharge elements are provided within the container that are connected via a connection to a source for air, gas or the like.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

**BEST AVAILABLE COPY**



(19) BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

(12) Offenlegungsschrift  
(10) DE 41 09 908 A 1

(51) Int. Cl. 5:  
**G 01 R 31/26**  
G 01 R 31/28  
G 01 M 19/00

DE 41 09 908 A 1

(21) Aktenzeichen: P 41 09 908.7  
(22) Anmeldestag: 26. 3. 91  
(43) Offenlegungstag: 1. 10. 92

(71) Anmelder:  
Reitinger, Erich, 8034 Germering, DE

(74) Vertreter:  
Reinhard, H., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.; Skuhra, U.,  
Dipl.-Ing.; Weise, R., Dipl.-Ing., Pat.-Anwälte, 8000  
München

(72) Erfinder:  
gleich Anmelder

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit  
in Betracht zu ziehende Druckschriften:  
DE 27 53 684 A1  
DD 2 55 410 A1  
US 46 65 360  
DE-Z: POTOTSCHNIG, H.: Positionieren und Kontaktieren von Wafern. In: Elektronik Produktion und Prüftechnik 1982, Teil 1, S.442-444;  
Teil 2, S.485-487 US-Z: BUOL, Douglas  
A.: High-temperature wafer prober predicts yield problems early. In: Electronics May 3, 1984,  
S.141-144;

(54) Anordnung zur Prüfung von Halbleiter-Wafern oder dergleichen

(57) Eine Anordnung zur Prüfung von Halbleiter-Wafern oder dergleichen enthält einen Probartisch zur Aufnahme der zu prüfenden Halbleiter-Wafer oder dergleichen und eine Halterung zur Aufnahme von Sonderhaltern. Der Probartisch ist innerhalb eines Behälters, der nach oben offen ausgebildet ist, angeordnet und durch eine Platte abgedeckt, die eine Öffnung zur Durchführung von Sonden enthält. Innerhalb des Behälters sind Ausströmelemente vorgesehen, die über eine Verbindung an eine Quelle für Luft, Gas oder dergleichen angeschlossen sind.

DE 41 09 908 A 1

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Prüfung von Halbleiter-Wafern oder dergleichen gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Die Prüfung von Halbleiter-Wafern wird in Temperaturbereichen von  $-200^{\circ}\text{C}$  bis  $+400^{\circ}\text{C}$  durchgeführt. Diese Temperaturwerte werden durch Kühlung und/oder Beheizung eines Probortisches durchgeführt, auf dem die Halbleiter-Wafer zu Prüfzwecken aufgelegt werden. Im Bereich um und unter  $0^{\circ}\text{C}$  werden auf den Wafern sowie auf den Probortischen selbst Eiskristalle erzeugt, die sich infolge der Feuchtigkeit der Umgebungsluft ergeben. Zur Vermeidung derartiger Eiskristalle wird bei manuell bedienbaren Probern ein Stickstoffstrahl auf den Prober gerichtet. Bei dieser Methode wird zwar im Kernbereich des Stickstoffstrahles die Erzeugung von Eiskristallen verhindert, jedoch wird durch das Ansaugen der Umgebungsluft an den Randbereichen des Stickstoffstrahles auf den Halbleiter-Wafern eine Eiskristallbildung nicht verhindert.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung der eingangs genannten Art derart auszubilden, daß im Betrieb bei Temperaturen um und unter  $0^{\circ}\text{C}$  die Erzeugung von Eiskristallen verhindert wird und daß im Betrieb oberhalb von  $0^{\circ}\text{C}$  Beeinträchtigungen durch Staub und/oder Oxidation vermeidbar sind.

Diese Aufgabe wird erfundungsgemäß dadurch gelöst, daß der nach oben offene Behälter durch eine Platte abgedeckt ist, die eine Öffnung zur Durchführung von Sonden enthält, und daß innerhalb des Behälters Ausströmelemente vorgesehen sind, die über eine Verbindung an eine Quelle für Luft, Gas oder dergleichen angeschlossen sind.

Die Erfindung schafft eine Anordnung zur Prüfung von Halbleiter-Wafern, mit der bei einer Kühlung durch den Probortisch auf Temperaturen um oder unter  $0^{\circ}\text{C}$  die Erzeugung von Eiskristallen verhindert wird, ferner bei Temperaturen oberhalb von  $0^{\circ}\text{C}$  Reinraumbedingungen einhaltbar sind und bei speziellen Anwendungszwecken Oxidationserscheinungen an den Spitzen der Sonden verhindert werden können.

Bei der erfundungsgemäßen Anordnung ist der Probortisch innerhalb eines nach oben offenen Behälters angeordnet, wobei der Probortisch entweder zusammen mit dem Behälter oder relativ zum Behälter in einer horizontalen Ebene verfahrbar ist. Der nach oben offene Behälter ist durch eine Platte mit einer Öffnung abgeschlossen, wodurch der Probortisch innerhalb eines durch den Behälter und die Platte definierten Raumes angeordnet ist. Durch die Plattenöffnung kontaktieren Sonden die zu prüfenden Halbleiter-Wafer. Zur Vermeidung von Eiskristallbildung und/oder des Eindringens von Staubpartikeln wird über innerhalb des Behälters liegende Ausströmelemente ein Gas bzw. Luft mit der erforderlichen Temperatur und/oder dem gewünschten Taupunkt in den Behälter geleitet. Die Strömungsgeschwindigkeit ist derart gewählt, daß eine laminare Strömung gewährleistet ist und eine vorbestimmte Menge an durch die Plattenöffnung austretender Luft erreicht wird.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der erfundungsgemäßen Anordnung bestehen die Ausströmelemente aus porösen Körpern, beispielsweise in Form von zylindrischen Rohren, deren Porösität derart gewählt ist, daß das Gas oder die Luft gleichmäßig über die gesamte Länge der Ausströmelemente in den Innenraum des Behälters austritt und dadurch Turbulenzen

innerhalb des Behälters vermieden werden.

Im folgenden wird eine bevorzugte Ausführungsform der erfundungsgemäßen Anordnung anhand der Zeichnung zur Erläuterung weiterer Merkmale beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische, teilweise im Schnitt gehaltene Ansicht der Anordnung, und

Fig. 2 eine schematische Teilaufsicht auf die Anordnung entlang der Linie 2-2' ein Fig. 1.

Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung eine Anordnung zur Prüfung von Halbleiter-Wafern, Hybridschaltungen oder dergleichen, mit einem Probortisch 1, der zur Aufnahme von Halbleiter-Wafern dient und in bekannter Weise an seiner Oberfläche mit schmalen, vorzugsweise kreisförmigen verlaufenden Nuten ausgebildet ist, die über ein nicht angezeigtes Anschlußsystem dazu dienen, einen Unterdruck gegenüber dem aufgelegten Halbleiter-Wafer auszuüben und den Halbleiter-Wafer auf dem Probortisch 1 zu halten. Der Probortisch

1 ist ferner mit Elementen zur Heizung und/oder Kühlung ausgerüstet. Ein derartiger Probortisch 1 ist sowohl in horizontaler Ebene, d. h. in X- und Y-Richtung verfahrbar, wie auch in einer vertikalen Richtung verlagerbar. Gemäß der dargestellten Ausführungsform der Anordnung ist an der Lagerung 3 des Probortisches 1 ein oben offener Behälter 2 befestigt, der gemäß dieser Ausführungsform zusammen mit dem Probortisch 1 verfahrbar ist und aus einem Boden 2a sowie vier Seitenwänden 2b besteht. Die Seitenwände 2b haben eine Höhe, derart, daß der Probortisch 1 innerhalb dieses Behälters 2 zu liegen kommt und die Oberfläche des Probortisches 1 unterhalb der oberen Kanten der Seitenwände 2b zu liegen kommt. Zwischen der mit 3 bezeichneten Lagerung des Probortisches 1 und dem Boden 2a ist eine geeignete Dichtung angeordnet, die in Fig. 1 nicht gezeigt ist und ein Ausströmen des im Behälter 2 befindlichen Gases oder Luft nach unten ausschließt.

Seitlich des Probortisches 1 sind z. B. in zueinander paralleler Anordnung Ausströmelemente 5, 6 vorgesehen, die über einen Verbindungsabschnitt 7 (Fig. 2) miteinander in Verbindung stehen und über einen Anschluß 8 an eine Quelle 9 angeschlossen sind. Die Quelle 9 erzeugt das Gas, das in das Innere des Behälters 2 geleitet wird, um eine laminare Strömung zu erzeugen. Der Anschluß 8 ist, wie Fig. 2 zeigt, durch eine der Seitenwände 2b durchgeführt, derart, daß der Anschluß 8 gegenüber der betreffenden Seitenwand 2b zur Vermeidung eines Austritts von Luft oder Gas abgedichtet ist. Die Ausströmelemente 5, 6 können gegenüber dem Boden 2a oder den Seitenwänden 2b des Behälters 2 durch Halteklemmen oder dergleichen fixiert sein.

Die Oberseite des nach oben offenen Behälters 2 ist durch eine Platte 10 abgedeckt, die eine mittige Öffnung 12 enthält, die vorzugsweise kreisförmige Gestalt hat und mittig gegenüber der Mitte des ebenfalls kreisförmigen Probortisches 1 ausgerichtet ist. Die Platte 10, beispielsweise aus Blech, ist gegenüber der gesamten Anordnung fixiert, so daß der Probortisch 1 gemäß dieser Ausführungsform zusammen mit dem Behälter 2 in horizontaler Richtung gegenüber der Platte 10 und einer Sondenhalterung 14 verstellbar ist.

Die Sondenhalterung 14 wie auch der Probortisch 1 mit seiner Lagerung 3 sind gegenüber einem nicht gezeigten Rahmen gelagert, wobei die Sondenhalterung 14 durch mehrere Säulenführungen gegenüber dem Rahmen 1, gegebenenfalls verstellbar, gelagert ist. Die Säulenführungen der Sondenhalterung 14 sind in Fig. 1 mit 18 bezeichnet. Auf der Sondenhalterung 14 sind

mehrere Sonderhalter 15, 16 montiert, die ihrerseits die zu benutzenden und in Fig. 1 nicht gezeigten Sonden aufnehmen.

Die Öffnung 12 der Platte 10 ist derart konzipiert, daß die von den Sonderhaltern 15, 16 gelagerten Sonden einen Spitzenkontakt zu den zu prüfenden Halbleiter-Wafern ermöglichen. Im Bedarfsfall kann die Öffnung 12 durch einen Ring 20, beispielsweise aus Plexiglas, abgeschlossen werden, der eine ebenfalls vorzugsweise kreisförmige Öffnung 22 enthält, welche kleiner ist als die Öffnung 12. Der Ring 20 hat dabei einen Außen-durchmesser, der geringfügig größer ist als der Durchmesser der Öffnung 12.

Mittels des Ringes 20, der entweder auf der Platte 10 aufliegt oder in eine ringförmige Nut der Platte 10 im Bereich deren Öffnung 12 eingesetzt wird, die seitlich der Öffnung 12 ausgebildet ist, wird eine Verringerung des Querschnittes der Öffnung 12 im Bedarfsfalle erreicht.

Bei der in Fig. 1 und 2 gezeigten Ausführungsform ist eine Verstellung des Probertiesches 1 gegenüber der Sonderhalterung 14 und den in den Sonderhaltern 15, 16 eingespannten Sonden möglich, um ein schrittweises Abtasten der auf dem Probertiesch 1 aufliegenden Halbleiter-Wafern zu realisieren. Gemäß der dargestellten Ausführungsform wird der Probertiesch 1 zusammen mit dem Behälter 2 in X- und Y-Richtung verstellt, um die Prüfung der einzelnen Halbleiter-Wafer zu ermöglichen, die auf einer Trägerschicht angeordnet sind.

Durch die Ausströmelemente 5, 6 wird eine Strömung innerhalb des Behälters 2 erzeugt, die gleichmäßig aus den Ausströmelementen 5, 6 austritt und eine nicht turbulente Luftströmung innerhalb des Behälters 2 erzeugt. Hierdurch wird ein schwacher Luftstrom oder Gasstrom in Richtung der Öffnung 12 erzeugt, wobei diese Luft- oder Gasströmung gleichmäßig aus der Öffnung 12 austritt. Dadurch wird der Eintritt von Umgebungsluft oder von Partikeln aus der Umgebung in das Innere des Behälters 2 verhindert.

Als Ausströmelemente 5, 6 dienen vorzugsweise zylindrische Rohre, beispielsweise aus Keramik, Kunststoff oder Kunstfaser, mit einer Porenichte in Größenordnung von 1 bis 30 µm. Diese rohrförmigen Ausströmelemente 5, 6 sind gemäß Fig. 2 an der Seite mit ihrem freistehenden Ende abgeschlossen, wodurch das Ausströmen von Luft oder Gas im wesentlichen in Radialrichtung zu den Ausströmelementen 5, 6 gewährleistet ist. Untersuchungen haben gezeigt, daß bei einer Anordnung mit dem vorstehend beschriebenen Aufbau stets eine konstante Luftvolumenemission aus der Öffnung 12 gegeben ist, wobei die Luft nur geringfügig abgekühlt wird, nachdem sie an der Oberfläche der zu prüfenden Halbleiter-Wafer passiert ist. Unterhalb des Probertiesches 1 ist ebenfalls ein durch den Probertiesch 1 hervorgerufener Kühlleffekt festzustellen, wobei die Temperatur allerdings im Vergleich zu der durch die Ausströmelemente 5, 6 zugeführten, getrockneten Luft bei einer Oberflächentemperatur des Probertiesches 1 von etwa -55°C nur verhältnismäßig niedriger ist als die durch die Ausströmelemente 5, 6 zugeführte Lufttemperatur von beispielsweise 20°C. Damit beschränkt sich bei der beschriebenen Anordnung der Kühlleffekt des Probertiesches 1 vorteilhafterweise nur auf die zu prüfenden Halbleiter-Wafer, während andere Teile innerhalb des Raumes des Behälters 2 durch die Kühlung des Probertiesches 1 nicht beaufschlagt werden.

Der vom Probertiesch 1 erzeugte Unterdruck zur Halterung der Halbleiter-Wafer ist im Vergleich zu dem

von den Ausströmelementen 5, 6 zugeführten Luftvolumen vernachlässigbar und beeinträchtigt nicht die innerhalb des Behälters 2 gewünschte laminare Luftströmung.

Somit konzentriert sich die Kühlung aufgrund des Probertiesches 1 bei der beschriebenen Anordnung auf die aufgelegten Halbleiter-Wafer, der übrige Aufbau verbleibt weitgehend auf derjenigen Temperatur, die der Temperatur der durch die Ausströmelemente 5, 6 zugeführten Luft entspricht.

Die erfundungsgemäße Anordnung läßt sich auch zur Einhaltung von Reinraumbedingungen einsetzen, d. h. für die Prüfung von Halbleiter-Wafern bei Temperaturen oberhalb von 0°C, z. B. bei Raumtemperatur. Bei dieser Anwendungsart wird Luft mit der jeweils gewünschten Partikelreinheit in den Behälter 2 eingeführt und es wird verhindert, daß von oben über die Öffnung 12 Schmutzpartikel in den Behälter 2 eintreten. Bei Anwendung der beschriebenen Anordnung unter Reinraumbedingungen bedarf es nicht unbedingt des Einsatzes reiner Luft, jedoch der Zuführung von gefilterter Luft.

Eine weitere Anwendung der beschriebenen Anordnungen liegt in der Überprüfung von Halbleiter-Wafern bei höheren Temperaturen. Bei höheren Temperaturen können an den Nadelspitzen Oxidationen auftreten. Unter Einsatz der erfundungsgemäßen Anordnung läßt sich dies dadurch verhindern, daß durch die Ausströmelemente 5, 6 ein Edelgas (z. B. Argon oder Sauerstoff) in den Innenraum des Behälters 2 geleitet wird und dadurch die Prüfspitzen der von den Haltern 15, 16 gehaltenen Sonden sich stets in einem Edelgasstrom befinden und dadurch Oxidationen, die zu Fehlmessungen führen, verhindert werden.

Wird die erfundungsgemäße Anordnung in Verbindung mit getrockneter Luft verwendet, deren Taupunkt beispielsweise bei -60°C liegt, kann es erforderlich sein, in dem Behälter 2 eine Ionisationseinrichtung vorzusehen, um die zu den Ausströmelementen 5, 6 geführte Luft vor deren Eingriff in den Behälter 2 zu ionisieren. Die Ionisierung der Luft hat den Zweck, einen Funkenüberschlag innerhalb des Behälters 2 bei der Überprüfung der Halbleiter-Wafer zu vermeiden.

Gemäß einer weiteren, in den Zeichnungen nicht dargestellten Ausführungsform, der erfundungsgemäßen Anordnung ist vorgesehen, daß der Probertiesch 1 relativ zum Behälter 2 verstellbar, insbesondere in X-Y-Richtung verstellbar ist. Um dies zu erreichen, ist der Boden 2 mit einer entsprechend großen Öffnung versehen, wobei innerhalb der Öffnung des Bodens 2a um die Lagerung 3 eine flexible Dichtung eingesetzt ist, um die Verstellung der Lagerung 3 relativ zum Boden 2a zu realisieren.

Um den Behälter 2 gegen die Unterfläche der Platte 10 zu halten, sind bei der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform Federeinrichtungen 25, 26 vorgesehen, die eine Vorspannungskraft erzeugen und die oberen Kanten der Behälterwände 2b gegen die untere Fläche der Platte 10 drücken.

Um eine ruckfreie Verschiebung des Behälters 2 gegenüber der Platte 10 zu vermeiden, d. h. um den Reibungswiderstand zwischen den oberen Kanten der Seitenwände 2b und der Platte 10 weitgehend zu reduzieren, sind bei einer bevorzugten Ausführungsform die nach oben weisenden Kanten der Seitenwände 2b abgerundet. Anstelle der Abrundungen der Kanten der Seitenwände 2b können zusätzliche Gleitelemente, z. B. die Kanten von oben eingesetzten Gleitstiften, vorgesehen

werden.

Zur besseren Einsicht in den Behälter 2 besteht dieser vorzugsweise aus Plexiglas.

Fig. 2 zeigt nur eine mögliche Ausführungsform der Ausströmelemente 5, 6, die im wesentlichen parallel zueinander liegend angeordnet sind und durch ein Verbindungsrohr 7 eine im wesentlichen U-förmige oder ringförmige Struktur ergeben. Anstelle des Verbindungsrohrs 7 kann ein entsprechendes Ausströmelement vorgesehen sein, das mit den anderen Ausströmelementen 5, 6 verbunden ist.

Die erfundungsgemäße Anordnung läßt sich in der nachstehenden Weise verwenden:

Bei Prüfvorgängen in Temperaturbereichen von -200°C bis +400°C, die vom Probertisch 1 an seiner Oberfläche gegenüber den aufliegenden Halbleiter-Wafern erzeugt werden, wird zur Vermeidung von Eiskristallbildung von der Quelle 9 eine Luftströmung erzeugt, die beispielsweise eine Temperatur von 20°C hat und einen Taupunkt bei ungefähr -60°C besitzt.

Bei der erfundungsgemäßen Anordnung, die sich insbesondere für manuell bedienbare Prober eignet, läßt sich der wattenförmige Behälter 2 soweit in der horizontalen Ebene verschieben, daß er durch Verlagerung gegenüber der oben liegenden Platte 10 nach Art einer Schubladenfunktion den Zugang auf den Probertisch 1 ermöglicht, um ein Auswechseln der Halbleiter-Wafer zu ermöglichen.

Bei der Überprüfung von Wafern können Sonden in Form von Prüfnadeln und/oder Nadelkanten zum Kontaktieren der Wafer, Hybridschaltungen oder dergleichen eingesetzt werden.

#### Patentansprüche

35

1. Anordnung zur Prüfung von Halbleiter-Wafern oder dergleichen, mit einem Probertisch (1) zur Aufnahme der zu prüfenden Halbleiter-Wafer oder dergleichen, mit einer Halterung (14) zur Aufnahme von Sondenhaltern (15, 16) dadurch gekennzeichnet,  
daß der Probertisch (1) innerhalb eines Behälters (2) angeordnet ist, der nach oben offen ausgebildet ist,  
daß der nach oben offene Behälter (2) durch eine Platte (10) abgedeckt ist, die eine Öffnung (12) zur Durchführung von Sonden enthält, und  
daß innerhalb des Behälters (2) Ausströmelemente (5, 6) vorgesehen sind, die über eine Verbindung (8) an eine Quelle (9) für Luft, Gas oder dergleichen angeschlossen sind.
2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Behälter (2) fest mit dem Probertisch (1) verbunden ist.
3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Probertisch (1) gegenüber dem Behälter (2) verstellbar angeordnet ist.
4. Anordnung nach wenigstens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausströmelemente (5, 6) aus einem porösen Material bestehen, derart, daß im Behälter (2) eine laminare Luftströmung oder Gasströmung erzeugt wird.
5. Anordnung nach wenigstens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Quelle (9) an welche die Ausströmelemente (5, 6) angeschlossen sind, Luft mit ca. 20°C und einem Taupunkt bei -196°C erzeugt.

6. Quelle nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß gefilterte Luft zu den Ausströmelementen (5, 6) geführt wird.
7. Quelle nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß von der Quelle (9) Edelgas zu den Ausströmelementen (5, 6) geleitet wird.
8. Anordnung nach wenigstens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß im Behälter (2) eine Einrichtung zur Ionisierung der Luft vorgesehen ist.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

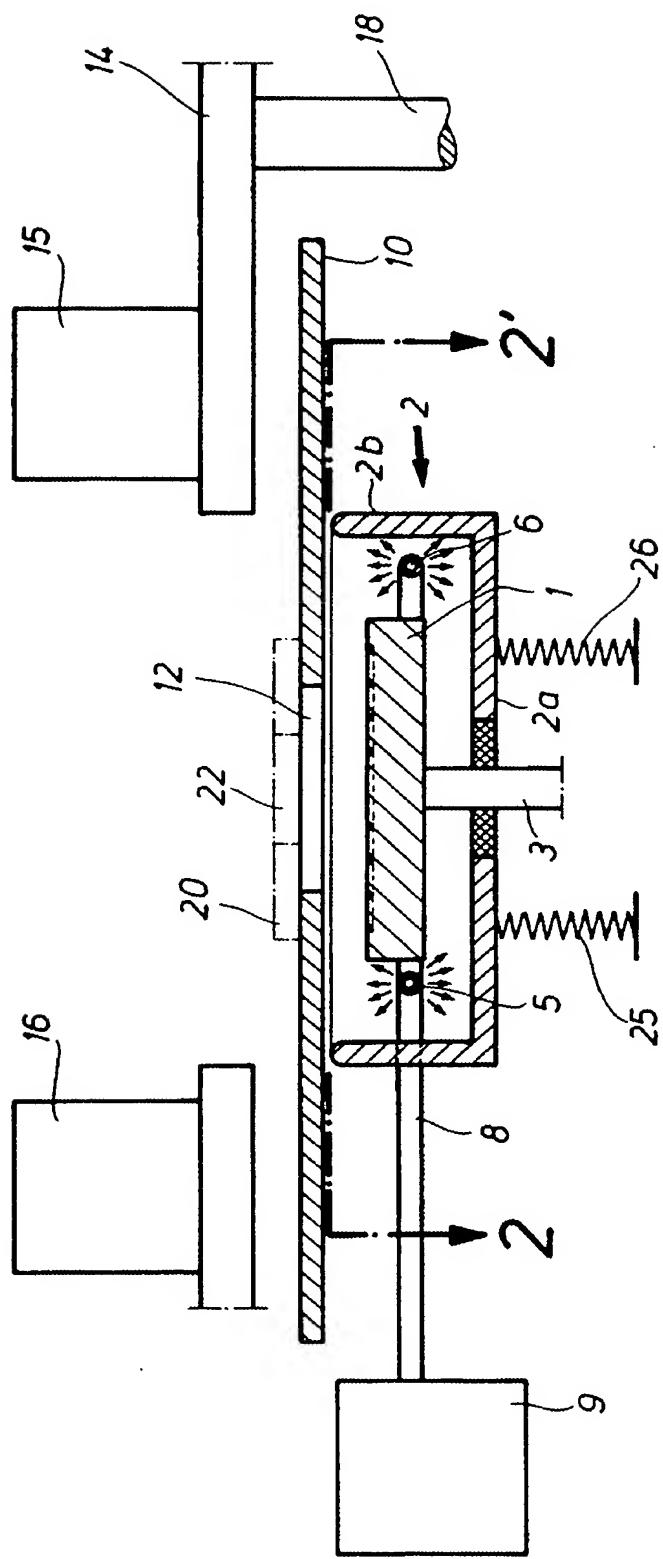
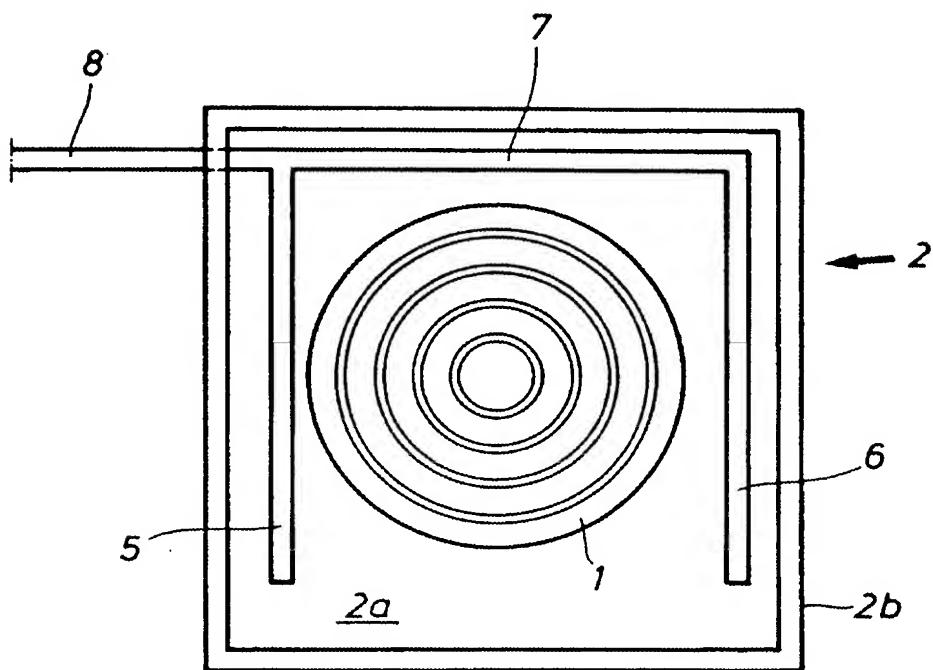


Fig. 1



*Fig.2*